

MES 2003

10月16日(木)

	A室(3F MOホール)	B室(2F 会議室2)	C室(2F 会議室3)	D室(1F 会議室1)
9:00	登録受付(1F エントランスホール)			
9:45	【1A1】鉛フリーはんだ 座長: 竹本 正(大阪大学) 1. Sn/Ag/Cu 系はんだの機械的/冶金学的特性に及ぼす Ag の影響 佐藤光司、岩田健吾、庄司辰也、藤吉 優、伊達正芳(日立金属) 2. 高信頼性鉛フリーはんだの検討 豊田良孝、田島 武(千住金属工業)、雨海正純(日本テキサスインスツルメンツ) 3. 微小引張試験片を用いたはんだ合金の力学特性評価 苅谷義治(物質・材料研究機構)、須賀唯知(東京大学) 4. 各種鉛フリーはんだ銅箔の細り現象の検証 棚阪 貴、中島新作、金井和久、竹内 誠(日本ビクター)、菅沼克昭、金 權録(大阪大学)	【1B1】回路基板 座長: 馬場 和宏(日本電気) 1. 液晶ポリマー銅張積層板の特性と応用 植田和憲、高田勝美、西本秀昭、山田浩之(新日鐵化学) 2. ガラス織布基材を用いた ALMV ピア接続 越後文雄、越智正三、平山久美子、中桐康司(松下電器産業) 3. 金属銅ハンブを用いた層間接続した高信頼性ビルドアップ配線板の開発 中村 恒(中村表面技術研究所)、吉村栄二(ダイワ工業) 4. 銅ダイレクト加工法によるプリプレグビルドアップ基板の量産化 立川 洋、木村茂治、山田智之(日本アイ・ピー・エム)	【1C1】評価・シミュレーション 座長: 福岡 義孝(ウェイスティール) 1. BGA はんだ接合部の信頼性におけるパラメータの影響度評価 陳 在哲、于 強、阿部浩和、白鳥正樹(横浜国立大学) 2. はんだ接合部の落下衝撃信頼性評価に関する研究 - 試験装置の検討 - 渡辺啓治、于 強、白鳥正樹、鶴澤俊浩(横浜国立大学) 3. 近似波形を利用した半導体パッケージの剥離部位の推定法 上野一也、猪口憲一、十河英彦、大久保孔明、林富美男(コベルコ科研) 4. 非水浸式超音波検査法による実装基板上の電子部品の検査事例 竹内 健、川上直哉、山本 登、宮田 徹(日立建機ファインテック)、山本 弘(日立建機)	
11:05				
11:15	【1A2】鉛フリーはんだ 座長: 細田 直江(物質材料研究機構) 1. Sn-Ag-Al ソルゲ合金箔/Cu 接合における組織と熱疲労特性 鈴木直人、水野宏紀、田中順一、成田敏夫(北海道大学)、高島敏行(北海道工業大学) 2. Sn-Ag 系鉛フリーはんだと Ni-P めっきとの界面形成および成長メカニズムにおける Cu 添加の影響 黄 致元、菅沼克昭(大阪大学)、木曾雅之、橋本滋雄(上村工業) 3. 無電解 Ni-P/Au めっきパッドと Sn-Ag 系鉛フリーはんだの界面構造と接合強度 平森智幸、廣瀬明夫、小林紘二郎(大阪大学)、伊藤元剛、谷井義治(東レリサーチセンター) 4. Sn-Ag はんだを用いたマイクロ接合部の金属間化合物化に関する研究 山本孝志、酒谷茂昭、上西啓介、小林紘二郎(大阪大学)、石尾雅昭、塩見和弘、橋本彰夫(住友特殊金属)、山本雅春(鹿児島住持電子)	【1B2】回路基板 座長: 菅沼 克昭(大阪大学) 1. 薄膜ドライフィルムレジストを利用した低価格と高密度を両立させるビルドアップ基板の開発 乃万裕一、中西 徹(日本アイ・ピー・エム) 2. ビルドアップ基板の導体の粗さによる損失の解析 小林和貴(新光電気工業) 3. 高密度配線/小径曲げ対応多心光コネクタの開発 細谷俊史、大塚健一郎(住友電気工業) 4. フェムト秒レーザーによるポリイミド光導波路の作製 瀬崎文康、南村清之(鐘淵化学工業)、鎌田賢司、金高健二、西井準治(産業総合研究所)	【1C2】評価・シミュレーション 座長: 于 強(横浜国立大学) 1. 高精度 3次元リフロー熱解析技術の開発 辻 陽子、垣野 学、古澤幹男(松下電器産業) 2. 樹脂をコアとするハンダ接合材料の熱伝導性について 豊嶋 勉、沖永信幸(積水化学工業) 3. パワーデバイスにおけるリードフレーム構造に関する検討 飯塚祐二、池田良成、吉原克彦、山下満男(富士電機総合研究所) 4. 高感度センサにおける微小接着層の影響 安藤幸也、新帯 亮、薫田智仁(デンソー)	【1D2】実装プロセス 座長: 齊藤 雅之(東芝) 1. はんだ接合同時接合法(PCF: Post Connectable FPC)によるFPC接続技術開発 戸谷 眞、三宅敏弘、近藤宏司(デンソー)、東田明也(デンソーエレクトクス)、黒崎礼郎(三菱樹脂) 2. フレキシブル基板における溶融ハンブ・フリップチップの実装技術 鳥山和重、高谷敏之(サンミナーSCIシステムズ・ジャパン) 3. 層メッキハンブを用いたフレキシブル基板へのフリップチップ実装技術 折井靖光、森日出雄(日本アイ・ピー・エム)、西村雅史(アイテス) 4. In 薄膜による Cu/Cu 直接接合プロセス 谷口克己、下田将義、後藤友彰(富士電機)、山田利典、安田清和、藤本公三(大阪大学)
12:35				
昼 休 み				
13:30	【1A3】鉛フリーはんだ 座長: 上西 啓介(大阪大学) 1. 無電解 Ni-P/Au めっきの耐湿放置後のはんだ付き性について 高岡英清、小川 誠、小西美穂、浜田邦彦(村田製作所) 2. 高温高湿下での Sn-Zn-Bi 系鉛フリーはんだ継ぎ手部の強度低下に及ぼすフラックスの影響 藤内伸一、尾山幸史、折井靖光(サンミナーSCIシステムズ・ジャパン) 3. Sn-8Zn-3Bi はんだを用いた CSP 実装における継手信頼性に及ぼす界面構造の影響 十河陽介、岩西宏昭、北条隆志、廣瀬明夫、小林紘二郎(大阪大学)、山口敦史、古澤彰男、西田一人(松下電器産業) 4. 鉛フリー Sn-Zn-Al はんだの金属組織検討 北嶋雅之、庄野忠昭(富士通)、萩野武久、小林鉄矢(富士通周辺機)	【1B3】ナノテクノロジー 座長: 着本 享(京都大学) 1. 銀ナノ粒子を用いた実装プロセスの基礎的検討 井出英一、安形真治、廣瀬明夫、小林紘二郎(大阪大学) 2. 貴金属ナノ粒子ペーストによる電子回路パターン形成 中野昌美、山本真理(大阪市立工業研究所)、垣内宏之、吉田幸雄(大研化学工業) 3. 金属ナノ粒子の選択的集積による微細配線形成 長谷川潤、赤松謙祐、縄舟秀美(甲南大学) 4. 銅ナノ粒子複合ポリイミド樹脂と銅めっき皮膜のナノスケール接合に関する研究 皮田慎吾、赤松謙祐、縄舟秀美(甲南大学)、出来成人(神戸大学)	【1C3】設計・評価技術 座長: 縄舟 秀美(甲南大学) 1. 超高密度薄型基板(MLTS)の電気特性評価 井上博文、堺 淳、下戸直典(日本電気)、本永和広(NEC エレクトロニクス) 2. 高速 BGA デバイスのタイミング用実装及び PCB インターコネクト電気特性技術の検討 上田千寿(イー・イー・ティー・ジャパン)、細谷武史、関 忍(日本CMK)、田原啓輔(データプローブ)、秋山 豊、大塚寛治(明星大学) 3. スーパーコネクタレベルの微細配線パターンの電氣的信頼性の EIS による評価 佐藤 誠、横田淳一郎、吉原佐知雄、白樫高史(宇都宮大学) 4. 分割された電源層を持つ IC 搭載プリント板における不要輻射と低減 芳賀 知、中野 健(超先端電子技術開発機構)、橋本 修(青山学院大学)	【1D3】生産技術・装置・システム 座長: 佐藤 了平(大阪大学) 1. 酸性電解水を用いた環境配慮型の精密洗浄技術 吉池 潤、竹ノ内敏一、田中博志、若林信一(新光電気工業) 2. オブジェクト指向による生産システムの開発とパッケージ・実装技術への適用 三水宏章(新光電気工業)、野瀬裕昭、西田崇(長野県情報技術試験場) 3. 電子部品材料の高周波振動打ち抜き加工特性 北島正邦、赤塩貞男、若林信一(新光電気工業)、小杉 俊、風間 武、工藤誠一(長野県工業試験場) 4. 液晶/パネル用テストセンサー 児島栄作、小林繁隆、和田彦彦(インターナショナルディスプレイテクノロジー)
14:50				
15:00	【招待講演】 座長: 榎本 亮(イビデン) 1. 「プラズマで生成したクラスターイオンを用いた空気清浄化技術」 西川 和男 氏(シャープ) 2. 「ユビキタス社会を支えるミューチップ技術(ゴマ粒チップ)」 井村 亮 氏(日立製作所)			
16:30	*おこたわり プログラムは変更になることがあります。ご了承ください。			
16:35	【表彰式】			
16:45	MES2002 ベストペーパー賞			
18:00	【懇親会】 会場/千里阪急ホテル(北大阪急行、大阪モノレール「千里中央駅から徒歩5分」)*専用バス運行予定			
20:00	料金/5,000円(消費税込)*MES参加費には含まれておりません			

MES 2003

10月17日(金)

	A室(3F MOホール)	B室(2F 会議室2)	C室(2F 会議室3)	D室(1F 会議室1)
9:00	登録受付(1F エントランスホール)			
9:45	【2A1】半導体チップ実装 座長: 江間 富世(パナソニックモバイルコミュニケーションズ) 1.接着樹脂層形成チップと超音波接合法を用いた Chip-On-Chip 集積化技術 栗田洋一郎、磯崎誠也、山田俊之、宮崎崇誌、吉野利枝(NEC エレクトロニクス) 2.超音波フリップチップボンディングを用いたチップオンチップ構造パッケージ開発 岩崎俊寛、富田至洋、木村通孝(ルネサステクノロジ) 3.超音波フリップチップ接合における課題解決とFPC基板への実装例 山内 朗、桑内重喜(東レエンジニアリング) 佐藤 茂、中居誠也(アルテクス) 4.アンダーフィル材の先塗布による Au-Sn 接合フリップチップ・ボンディング COF 技術開発 千野 満、原 秀和、赤羽隆行(ミス工業) 小笠原宏(京セラケミカル)	【2B1】ウェットプロセス スルーホールピアフィルバンプ形成 座長: 中岸 裕(奥野製薬工業) 1.三次元実装用貫通電極めっきの時間短縮 米澤裕浩、近藤和夫(岡山大学) 田口祐一、富坂 学、星野雅孝、高橋健司(超先端電子技術開発機構) 2.高アスペクトスルーホール貫通電極の作製 三上大輔、近藤和夫(岡山大学) 澤井章能、岡 誠次(三菱電機) 3.フィールドピア電気銅めっきにおけるフィリング性の電気化学的モニタリング法 水野由香、大久保利一、直井克巧(凸版印刷) 4.高密度接続 Cu コア - はんだバンプの作製 穆 道斌、近藤和夫、前田淳平(岡山大学)	【2C1】実装材料・部品 座長: 新井 進(信州大学) 1.アドバンスドリットコア工法による高精度 LC 内蔵基板の開発 橋本 晃、山田茂樹、勝又雅昭、岩佐正治、水野雅之(松下電子部品) 2.中空構造をもつ高周波用細径同軸ケーブル 田中晴士、海野大樹、渡辺和憲、松野繁宏(宇部日東化成) 菊地克弥、仲川 博、所 和彦、青柳昌宏(産業技術総合研究所) 3.レーザ照射による選択的はんだバリアエアの形成 野口 真、柳沢政志、倉科 匡(大和電気工業) 吉田善一(東洋大学) 縄舟秀美(甲南大学) 4.非導電性フィルムを用いた FPC 接続技術 川手 恒一郎(住友スリーエム)	【2D2】光実装 座長: 小池 真司(日本電信電話) 1.エピタキシャルリフトオフ(ELO)技術による光子素子の薄膜化 木下雅夫、比留間健之、三川 孝(超先端電子技術開発機構) 2.自己形成導波路を用いた光簡易接続技術 広瀬直宏、茨木 修(超先端電子技術開発機構) 3.プリント板を用いた光モジュールの試作 石塚 剛、三川 孝、茨木 修(超先端電子技術開発機構) 4.光・電気基板実装による EMI の低減効果 菊地秀雄、茨木 修(超先端電子技術開発機構) 森 敏則(NIT アドバンステクノロジ) 5.プラスチック光ファイバ(POF)配線板の開発 岡部雅寛、田淵久久、茨木 修(超先端電子技術開発機構)
10:55 (D室)				
11:05				
11:15	【2A2】半導体チップ実装 座長: 友景 肇(福岡大学) 1.5GHz SOI デバイスのフリップチップ実装による特性確認 永塚敏行、土門孝彰、近藤良一、安川芳行、山下喜就(TDK) 2.バンプ平坦化による低ストレス接合技術の開発 酒井泰治、岡本圭史郎、中川苗苗、石月義克、水越正孝(富士通研究所) 3.バンプレス TAB 工法による Cu / Low-k デバイス実装技術 栗田洋一郎、猪俣輝司、塩崎章雄、小田典明(NEC エレクトロニクス) 4.常温接合による半導体チップ実装技術の検討 中澤秀人、赤川雅俊(新光電気工業)	【2B2】ウェットプロセス 無電解めっき法 座長: 松岡 政夫(立命館大学) 1.無電解めっき方式による異方性 Ni バンプ形成とディップ方式によるはんだバンプ形成技術の検討 畑田賢造(アトムニクス研究所) 2.Sn-Ag-Pd 系触媒の開発と微細回路への応用 高橋久弥、吉原佐知雄、白樫高史(宇都宮大学) 伊崎昌伸(大阪市立工業研究所) 馬庭亮(トッパン NEC サーキットソリューション) 西條義司(上村工業) 3.銀ナノコロイド触媒を用いた無電解めっきプロセスの開発 北 晃治、大塚邦顕、岩松茂茂、片山順一(奥野製薬工業) 藤原 裕(大阪市立工業研究所) 4.TiO ₂ 量子効果を駆動力とする銅の Direct Patterning プロセスの開発 松原弘招、赤松謙祐、縄舟秀美(甲南大学)	【2C2】実装材料・部品 座長: 大塚 正久(芝浦工業大学) 1.高解像性を有する感光性フィルムの開発 中村幸二、北原 徹、稲葉真司、幡野千尋(新日鐵化学) 2.樹脂の表面改質を利用するポリイミド樹脂上への ITO 系薄膜の作製および光・電気特性 田口秀幸、赤松謙祐、縄舟秀美(甲南大学) 3.磁性ナノ粒子複合ポリイミド樹脂の微細構造制御および垂直磁気特性 新開寛之、赤松謙祐、縄舟秀美(甲南大学) 4.電着塗装法によるポジ型感光性ポリイミド膜の形成 上村貴之、大山俊幸、友井正男(横浜国立大学) 板谷 博(ピーアイ技術研究所)	
12:35				
昼 休 み				
13:30	【2A3】半導体パッケージ・モジュール 座長: 若林 信一(新光電気工業) 1.薄膜インターポーザを応用した高速伝送対応 System in Package 技術 岡本九弘、松本浩久、渡辺英二、村田浩一、依田博行、寺山 智、千葉修一、生雲雅光(富士通) 2.チップ埋込み型ウエーハレベル SIP 山形 修(ソニー) 3.パッケージ積層型 SiP の開発 熊谷欣一、高島 晃、西村隆雄、宇野 正、渡部光久(富士通) 4.プラズマ装置による Cu 貫通電極付きウエーハの裏面加工 丸崎恒司、田口裕一、上野光生、根本義彦、星野雅孝、高橋健司(超先端電子技術開発機構)	【2B3】ウェットプロセス ULSI 配線技術 座長: 藤原 裕(大阪市立工業研究所) 1.還元剤に DMAB を用いた無電解 NiB めっきの選択析出性における成膜条件の影響 里見宣彦、横島時彦、逢坂哲彌(早稲田大学) 2.AliWet Process による ULSI 配線 飯田貴久、吉野正洋、横島時彦、逢坂哲彌(早稲田大学) 3.銅析出の抑制剤の予備吸着を利用する ULSI 微細配線の形成 橋本守人、赤松謙祐、縄舟秀美(甲南大学) 内田 衛(石原薬品) 4.ULSI 上 5μm 厚めっき Cu 多層配線技術 菊池 克、高宮 真、工藤義治、水野正之、山道新太郎(日本電気) 副島康志、本多広一(NEC エレクトロニクス)	【2C3】樹脂接続 ACF 座長: 森 三樹(東芝) 1.異方導電性フィルムを用いたフレキシブル基板の接合評価 鈴木啓之、生田泰久、川端理仁(パナソニックモバイルコミュニケーションズ) 2.異方性導電接着フィルムの絶縁寿命の解析 野々山和美、新帯 亮(デンソー) 3.ACF 接続部の導電粒子分布と最低接続面積 野々山和美、新帯 亮(デンソー) 4.ACF を用いた FPC / ガラス基板接続の信頼性 宮本篤司、井上雅博、菅沼克昭(大阪大学)	【2D3】MEMS 座長: 江森 雄二(沖テッククリエーション) 1.マイクロ放電加工と LIGA プロセスの組み合わせによるプローブ先端形成技術 川瀬和典、羽賀 剛、依田 潤、平田嘉裕(住友電気工業) 2.化学気相成長法を用いたチップ貫通電極用銅配線の形成 小出知昭、関口 敦(アネルバ) 3.バイオ・医療利用のための流体 MEMS のデバイス化 磯田隆聡、今永広喜、橋爪伸朗、今村亮介、高原直己、森 龍平(北九州市立大学) 4.アルカリ溶液を用いた異方性エッチングによる Si 構造体形成技術 山口雄一郎、相馬伸一、鮫島友紀、加藤 誠、坂田晃治(富士電機) 5.微細加工技術対応の電鍍法により作製した低熱膨張 Fe-Ni 合金膜の機械的性質 永山富男、水谷 泰、中村俊博、篠原長政(京都市産業技術研究所)
14:50				
15:00	【2A4】半導体パッケージ・モジュール 座長: 橋本 薫(富士通研究所) 1.キャパシタ内蔵基板の電気特性検査に関する検討 近藤裕介、島田 靖(日立化成工業) 2.SrTiO ₃ 薄膜を用いた薄型フレキシブルキャパシタ 山道新太郎、渋谷明(日本電気) 3.Si 基板を用いた DC-DC コンバータの小型化技術 坂田晃次、松下浩二、大野勝史、佐々木敦(富士電機) 4.伝送線路形状電源ラインの検討 日下紀之、大塚寛治、秋山 豊(明星大学) 宇佐美保(東京大学)	【2B4】ウェットプロセス 実装材料 座長: 縄舟 秀美(甲南大学) 1.セミアディティブ法による 20μm リードピッチ以下の COF テープ 松浦 亮、珍田 聡、杉本 洋(日立電線) 2.エッチング法による 20μm リードピッチ COF テープの開発 珍田 聡、杉本 洋、柏原史隆(日立電線) 3.フィンピッチパターンから発生する Sn ウィスカ 栗原宏明、石井正人、片岡龍雄(三井金属鉱業) 近藤和夫(岡山大学) 4.高熱放射線を実現したカーボンナノファイバー・ニッケル複合めっき 酒井豊明、中沢昌夫、深瀬克哉、若林信一(新光電気工業) 金子紀男(信州大学)	【2C4】樹脂接続 導電性接着剤・アンダーフィル 座長: 天明 浩之(日立製作所) 1.CoTe 素子を用いた 線検出器モジュールの開発 菅謙太郎、樋口和人、宮城武史、牧野俊一郎、首藤隆世(東芝) 2.Ag-Sn 合金 - エポキシ系導電性接着剤を用いた高温信頼性に関する検討 山下宗哲、菅沼克昭(大阪大学) 白井恭夫(ナミックス) 森光正明(ミレニアムゲートテクノロジ) 3.携帯機器用アンダーフィル実装試験品の強度評価 矢口昭弘、中村真人、石川高司(日立製作所) 黒沢和仁(東海テック) 木本良輔(ルネサステクノロジ)	
15:10 (D室)				
16:20				*おこわり プログラムは変更になることがあります。 ご了承ください。